

## 9012S

硅 PNP 外延平面晶体管芯片 (4 " )

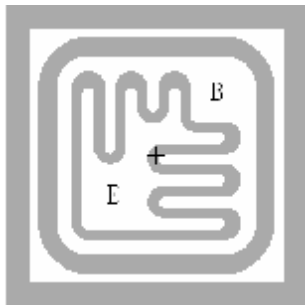
■用途:

- \*一般用途放大器
- \*中等功率驱动器
- \*中速开关应用

■特征:

- \*优越的  $h_{FE}$  线性
- \*与 9013S 配对
- \*集电极电流:0.5A
- \*有效管芯数(只):40350

■芯片示意图



■芯片结构

芯片尺寸	420 $\mu$ m $\times$ 420 $\mu$ m
压焊区尺寸	基 区 89 $\mu$ m $\times$ 89 $\mu$ m 发射区 89 $\mu$ m $\times$ 89 $\mu$ m
芯片厚度	220 $\pm$ 10 $\mu$ m
锯片槽宽度	60 $\mu$ m
金属层	正面:Al 1.85 $\pm$ 0.15 $\mu$ m 背面:Au 1.1 $\pm$ 0.2 $\mu$ m

■电特性(Ta=25°C)

参数名称	符号	测试条件	最小	最大	单位
集电极--基极击穿电压	$BV_{CBO}$	$I_C = -100 \mu A, I_E = 0$	-40		V
集电极--发射极击穿电压	$BV_{CEO}$	$I_C = -1 mA, I_B = 0$	-20		V
发射极--基极击穿电压	$BV_{EBO}$	$I_E = -100 \mu A, I_C = 0$	-5		V
集电极--基极截止电流	$I_{CBO}$	$V_{CB} = -25 V, I_E = 0$		-200	nA
发射极--基极截止电流	$I_{EBO}$	$V_{EB} = -4 V, I_C = 0$		-200	nA
直流电流增益	$h_{FE}$	$V_{CE} = -1 V, I_C = -50 mA$	80	600	
集电极--发射极饱和电压	$V_{CE(sat)}$	$I_C = -500 mA, I_B = -50 mA$		-0.6	V